

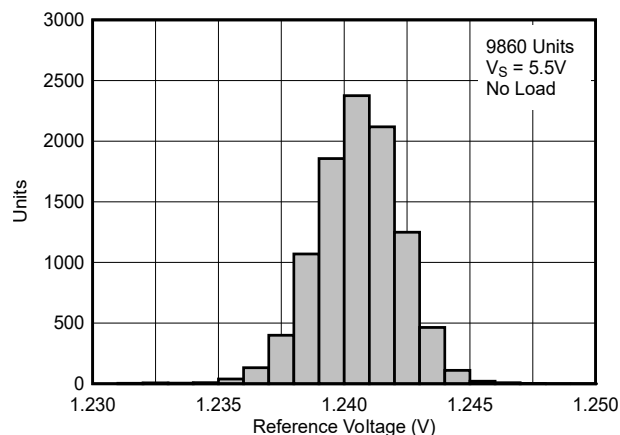
TLV3011-Q1、TLV3012-Q1、TLV3011B-Q1 和 TLV3012B-Q1 具有集成 1.24V 电压基准的低功耗比较器

1 特性

- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性：
 - 器件温度等级 1：-40°C 至 +125°C 环境温度范围
 - 器件 HBM ESD 分类等级 2
 - 器件 CDM ESD 分类等级 C3
- 低静态电流：3.1 μA (最大值, “B” 版本)
- 集成电压基准：1.242V
- 输入共模范围：超过电源轨 200mV
- 电压基准初始精度：1.5%
- 内置迟滞：6mV (典型值)
- 失效防护输入 (“B” 版本)
- 上电复位 (“B” 版本)
- 开漏输出选项 (TLV3011x-Q1)
- 推挽输出选项 (TLV3012x-Q1)
- 快速响应时间：2 μs (“B” 版本)
- 低电源电压 = 1.65V 至 5.5V (“B” 版本)

2 应用

- 车道偏离警告
- 仪表组
- 收费标签
- 资产跟踪
- 电池管理系统



TLV3012B-Q1 基准电压分布

3 说明

TLV3011-Q1 是一款低功耗、开漏输出比较器；TLV3012-Q1 是一款推挽输出比较器。这两款器件都具有非限定的片上电压基准，静态电流为 5 μA (最大值)，输入共模范围超出电源轨 200mV，单电源电压范围为 1.8V 至 5.5V。集成的 1.242V 系列电压基准提供 100ppm/°C (最大值) 的低温漂，在高达 10nF 的容性负载下保持稳定，并且可以提供高达 0.5mA (典型值) 的输出电流。

TLV3011B-Q1 和 TLV3012B-Q1 “B” 版本添加了上电复位 (POR)、失效防护输入、1.65V 的较低最小电源电压和 3.1 μA 的最大静态电流。

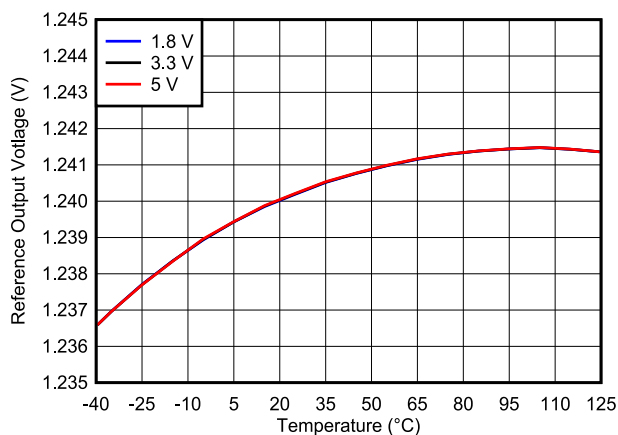
该系列采用微型 SOT23-6 和 SC-70 两种封装，前者可实现节省空间的设计，后者可进一步节省电路板面积。所有版本的额定工作温度范围均为 -40°C 至 +125°C。

封装信息

器件型号	封装 ⁽¹⁾	封装尺寸 ⁽²⁾
TLV3011A-Q1、 TLV3012A-Q1、 TLV3011B-Q1、 TLV3012B-Q1	DBV (SOT-23, 6)	2.9mm × 2.8mm
	DCK (SC-70, 6)	2mm × 2.1mm

(1) 如需了解所有可用封装，请参阅数据表末尾的可订购产品附录。

(2) 封装尺寸 (长 × 宽) 为标称值，并包括引脚 (如适用)。



TLV3012B-Q1 基准电压与温度间的关系



内容

1 特性	1	7.4 器件功能模式	14
2 应用	1	8 应用和实施	16
3 说明	1	8.1 应用信息.....	16
4 引脚配置和功能	3	8.2 典型应用.....	17
5 规格	4	8.3 系统示例.....	19
5.1 绝对最大额定值.....	4	8.4 电源相关建议.....	21
5.2 ESD 等级.....	4	8.5 布局.....	21
5.3 热性能信息.....	4	9 器件和文档支持	22
5.4 建议运行条件.....	4	9.1 接收文档更新通知.....	22
5.5 电气特性.....	5	9.2 支持资源.....	22
5.6 开关特性.....	7	9.3 商标.....	22
6 典型特性	8	9.4 静电放电警告.....	22
7 详细说明	14	9.5 术语表.....	22
7.1 概述.....	14	10 修订历史记录	22
7.2 功能方框图.....	14	11 机械、封装和可订购信息	23
7.3 特性说明.....	14		

4 引脚配置和功能

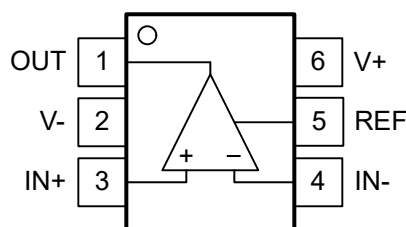


图 4-1. DCK , DBV 封装
6 引脚 SC-70、SOT-23
 顶视图

表 4-1. 引脚功能

引脚		I/O	说明
编号	名称		
1	OUT	O	比较器输出
2	V -	-	负电源 (最低)
3	IN+	I	同相比较器输入
4	IN-	I	反相比较器输入
5	REF	O	基准输出
6	V+	-	正电源 (最高)

5 规格

5.1 绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得 (除非另有说明) ⁽¹⁾

	最小值	最大值	单位
电源电压: $V_S = (V+) - (V-)$	-0.5	7	V
(V-) 的输入引脚 (IN+, IN-) ⁽²⁾	-0.5	7	V
(V-) 的输出 (OUT) (开漏) ⁽³⁾	-0.5	7	V
(V-) 的输出 (OUT) (推挽)	-0.5	(V+) + 0.5	V
输出短路电流 ⁽⁴⁾		10	mA
结温, T_J		150	°C
贮存温度, T_{stg}	-65	150	°C

- (1) 超出绝对最大额定值运行可能会对器件造成永久损坏。绝对最大额定值并不表示器件在这些条件下或在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出“建议运行条件”但在“绝对最大额定值”范围内使用, 器件可能不会完全正常运行, 这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。
- (2) 输入引脚被二极管钳制至 (V-)。只要在 -0.5V 至 7V 范围内, 输入 (IN+, IN-) 就可以大于 (V+)。超过 -0.3V 的输入必须被限制在少于 -10mA 的电流, 而超过 7V 的输入必须被外部钳位电压。
- (3) 只要输出电压在 -0.5V 至 7V 范围内, 开漏输出 (OUT) 就可以大于 (V+) 和输入 (IN+, IN-)。
- (4) 对 (V-) 或 (V+) 短路。

5.2 ESD 等级

			值	单位
$V_{(ESD)}$	静电放电	人体放电模型 (HBM), 符合 AEC Q100-002 标准 ⁽¹⁾	±2000	V
		充电器件模型 (CDM), 符合 AEC Q100-0111 标准	±1000	

- (1) AEC Q100-002 指示应当按照 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 规范执行 HBM 应力测试。

5.3 热性能信息

热指标 ⁽¹⁾		DCK (SC-70)	DBV (SOT-23)	单位
		6 引脚	6 引脚	
$R_{\theta JA}$	结至环境热阻	169.8	162.5	°C/W
$R_{\theta JC(top)}$	结至外壳 (顶部) 热阻	120.5	78.8	°C/W
$R_{\theta JB}$	结至电路板热阻	63.2	42.1	°C/W
Ψ_{JT}	结至顶部特征参数	45.9	21.2	°C/W
Ψ_{JB}	结至电路板特征参数	63.0	41.9	°C/W
$R_{\theta JC(bot)}$	结至外壳 (底部) 热阻	-	-	°C/W

- (1) 更多有关新旧热指标的信息, 请参阅 [半导体和 IC 封装热指标](#) 报告。

5.4 建议运行条件

在自然通风条件下的工作温度范围内测得 (除非另有说明)

		最小值	最大值	单位
电源电压： $V_S = (V+) - (V-)$		1.8	5.5	V
电源电压： $V_S = (V+) - (V-)$	B 版本	1.65	5.5	V
(V-) 的输入电压范围		-0.2	(V+) + 0.2	V
(V-) 的输出电压范围 (对于开漏)		-0.2	(V+)	V
(V-) 的输出电压范围 (对于开漏)	B 版本	-0.2	5.5	V
环境温度， T_A		-40	125	°C

5.5 电气特性

$T_A = 25^\circ\text{C}$, V_S (总电源电压) = $(V_+) - (V_-) = 1.8\text{V}$ 和 5.5V , $V_{CM} = V_S/2$ (除非另有说明)

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
失调电压						
V_{OS}	输入失调电压	$V_{CM} = (V_-)$	-6	± 0.3	6	mV
V_{OS}	输入失调电压	$V_{CM} = (V_-)$ $T_A = -40^\circ\text{C}$ 至 $+125^\circ\text{C}$	-9		9	mV
dV_{IO}/dT	输入失调电压温漂	$V_{CM} = (V_-)$ $T_A = -40^\circ\text{C}$ 至 $+125^\circ\text{C}$		± 12		$\mu\text{V}/^\circ\text{C}$
PSRR	电源抑制比	$V_{CM} = (V_-)$ $V_S = 1.8\text{V}$ 至 5.5V $T_A = -40^\circ\text{C}$ 至 $+125^\circ\text{C}$		100	1000	$\mu\text{V}/\text{V}$
PSRR	电源抑制比 (B 版本)	$V_{CM} = (V_-)$ $V_S = 1.65\text{V}$ 至 5.5V $T_A = -40^\circ\text{C}$ 至 $+125^\circ\text{C}$		100	1000	$\mu\text{V}/\text{V}$
V_{HYS}	输入迟滞电压	$T_A = -40^\circ\text{C}$ 至 $+125^\circ\text{C}$	2	6	8	mV
输入偏置电流						
I_B	输入偏置电流	$V_{CM} = V_S/2$	-10 ⁽¹⁾	± 4.5	10 ⁽¹⁾	pA
I_{OS}	输入失调电流	$V_{CM} = V_S/2$	-10 ⁽¹⁾	± 1	10 ⁽¹⁾	pA
输入共模范围						
$V_{CM\text{-Range}}$	共模电压范围	$V_S = 1.8\text{V}$ 至 5.5V	$(V_-) - 0.2$		$(V_+) + 0.2$	V
CMRR	共模抑制比	$V_{CM} = (V_-) + 1.5\text{V}$ 至 $(V_+) + 0.2\text{V}$ $V_S = 5.5\text{V}$	60	74		dB
CMRR	共模抑制比	$V_{CM} = (V_-) - 0.2\text{V}$ 至 $(V_+) + 0.2\text{V}$ $V_S = 5.5\text{V}$	54	62		dB
R_{CM}	输入共模电阻			10^{13}		Ω
C_{IC}	输入共模电容			2		pF
输入阻抗						
R_{DM}	输入差分模式电阻			10^{13}		Ω
C_{ID}	输入差分模式电容			4		pF
输出						
V_{OL}	(V_-) 的电压摆幅	$V_S = 5\text{V}$ $I_{SINK} = 5\text{mA}$ $T_A = -40^\circ\text{C}$ 至 $+125^\circ\text{C}$		160	200	mV
V_{OH}	(V_+) 的电压摆幅 (仅适用于推挽)	$V_S = 5\text{V}$ $I_{SOURCE} = 5\text{mA}$ $T_A = -40^\circ\text{C}$ 至 $+125^\circ\text{C}$		90	200	mV
电压基准						
V_{OUT}	基准电压		1.223	1.242	1.260	V
	精度			$\pm 0.25\%$	$\pm 1.5\%$	
dV_{OUT}/dT	温漂	$T_A = -40^\circ\text{C}$ 至 $+125^\circ\text{C}$		40	100	ppm/ $^\circ\text{C}$
dV_{OUT}/dI_{LOAD}	负载调节, 拉电流	$0\text{mA} < I_{SOURCE} \leq 0.5\text{mA}$		0.36	1 ⁽¹⁾	mV/mA
	负载调节, 灌电流	$0\text{mA} < I_{SINK} \leq 0.5\text{mA}$		6.6		mV/mA
I_{LOAD}	输出电流			0.5		mA
dV_{OUT}/dV_S	线性调整率	$1.8\text{V} \leq V_S \leq 5.5\text{V}$		10	100 ⁽¹⁾	$\mu\text{V}/\text{V}$
dV_{OUT}/dV_S	线路调节 (B 版本)	$1.65\text{V} \leq V_S \leq 5.5\text{V}$		10	100 ⁽¹⁾	$\mu\text{V}/\text{V}$
V_{noise}	噪声	$f = 0.1\text{Hz}$ 至 10Hz		0.2		mV _{PP}

5.5 电气特性 (续)

$T_A = 25^{\circ}\text{C}$, V_S (总电源电压) = $(V+) - (V-) = 1.8\text{V}$ 和 5.5V , $V_{CM} = V_S / 2$ (除非另有说明)

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
电源						
I_Q	静态电流 (每个比较器)	输出为逻辑高电平		2.8	5	μA
I_Q	静态电流 (每个比较器)	输出为逻辑高电平 $T_A = -40^{\circ}\text{C}$ 至 $+125^{\circ}\text{C}$			7	μA
I_Q	每个比较器的静态电流 (B 版本)	输出为逻辑高电平		2.4	3.1	μA
I_Q	每个比较器的静态电流 (B 版本)	输出为逻辑高电平 $T_A = -40^{\circ}\text{C}$ 至 $+125^{\circ}\text{C}$			3.6	μA

(1) 通过表征进行验证

5.6 开关特性

$T_A = 25^\circ\text{C}$, V_S (总电源电压) = $(V+) - (V-) = 1.8\text{V}$ 和 5.5V , $V_{CM} = V_S/2$ (除非另有说明)

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
输出						
T_{PD-LH}	传播延迟时间, 从低电平到高电平	$f = 10\text{kHz}$, $V_{STEP} = 1\text{V}$, $V_{OD} = 10\text{mV}$, $C_L = 10\text{pF}$		12		μs
T_{PD-LH}	传播延迟时间, 从低电平到高电平	$f = 10\text{kHz}$, $V_{STEP} = 1\text{V}$, $V_{OD} = 100\text{mV}$, $C_L = 10\text{pF}$		6		μs
T_{PD-LH}	传播延迟时间, 低电平到高电平 (推挽输出, B 版本)	$f = 10\text{kHz}$, $V_{STEP} = 200\text{mV}$, $V_{OD} = 100\text{mV}$, $C_L = 10\text{pF}$		2	4	μs
T_{PD-HL}	传播延迟时间, 高电平到低电平	$f = 10\text{kHz}$, $V_{STEP} = 1\text{V}$, $V_{OD} = 10\text{mV}$, $C_L = 10\text{pF}$		13.5		μs
T_{PD-HL}	传播延迟时间, 高电平到低电平	$f = 10\text{kHz}$, $V_{STEP} = 1\text{V}$, $V_{OD} = 100\text{mV}$, $C_L = 10\text{pF}$		6.5		μs
T_{PD-HL}	传播延迟时间, 高电平到低电平 (B 版本)	$f = 10\text{kHz}$, $V_{STEP} = 200\text{mV}$, $V_{OD} = 100\text{mV}$, $C_L = 10\text{pF}$		2	4	μs
T_{RISE}	输出上升时间, 20% 至 80%, 推挽输出	$C_L = 10\text{pF}$		100		ns
T_{RISE}	输出上升时间, 20% 至 80%, 推挽输出 (B 版本)	$C_L = 10\text{pF}$		10		ns
T_{RISE}	输出上升时间, 20% 至 80%, 开漏输出	$R_L = 10\text{k}\Omega$, $C_L = 10\text{pF}$		200		ns
T_{FALL}	输出下降时间, 80% 至 20%	$C_L = 10\text{pF}$		100		ns
T_{FALL}	输出下降时间, 80% 至 20% (B 版本)	$C_L = 10\text{pF}$		10		ns
T_{FALL}	输出下降时间, 80% 至 20%, 开漏输出	$R_L = 10\text{k}\Omega$, $C_L = 10\text{pF}$		200		ns
T_{FALL}	输出下降时间, 80% 至 20%, 开漏输出 (B 版本)	$R_L = 10\text{k}\Omega$, $C_L = 10\text{pF}$		10		ns
t_{ON}	上电时间 (B 版本)			1.9		ms

6 典型特性

$T_A = 25^\circ\text{C}$, V_S (总电源电压) = $(V_+) - (V_-) = +5\text{V}$, $V_{CM} = V_S / 2$, $R_{PULLUP} = 1\text{M}\Omega$ 至 V_+ , $C_L = 15\text{pF}$, $V_{OD} = 100\text{mV}$, 除非另有说明。

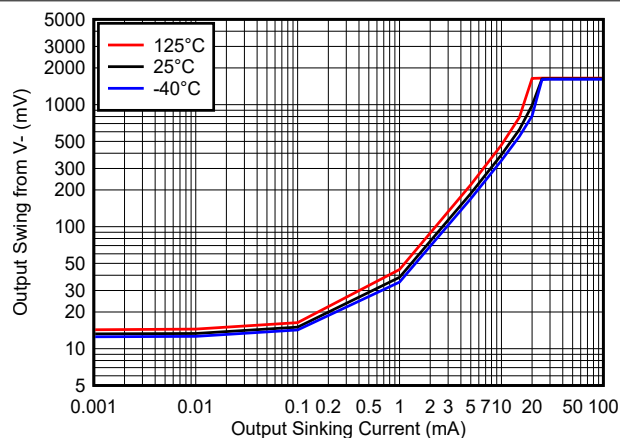


图 6-1. 输出摆幅与输出灌电流之间的关系 - 1.8V

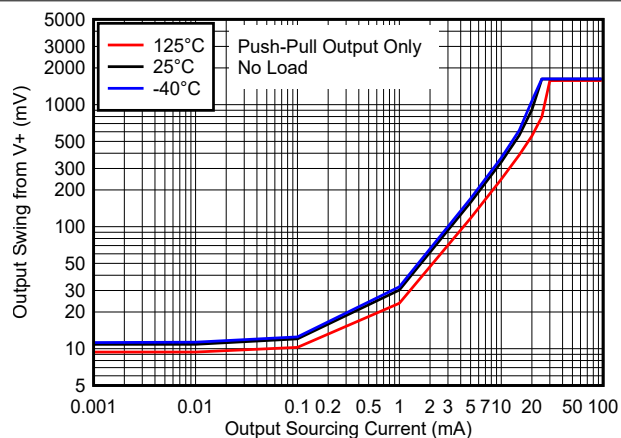


图 6-2. 输出摆幅与输出拉电流之间的关系 - 1.8V

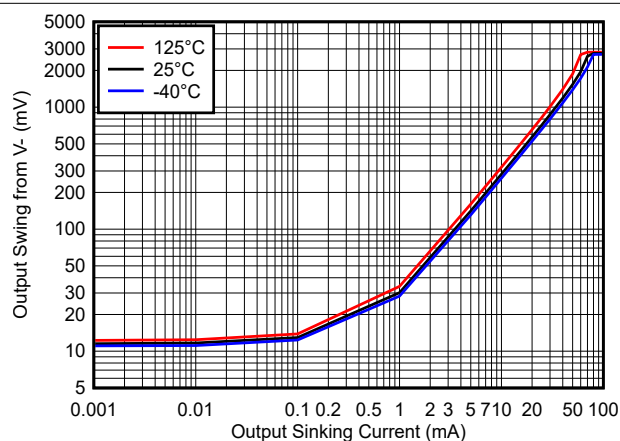


图 6-3. 输出摆幅与输出灌电流之间的关系 - 3.3V

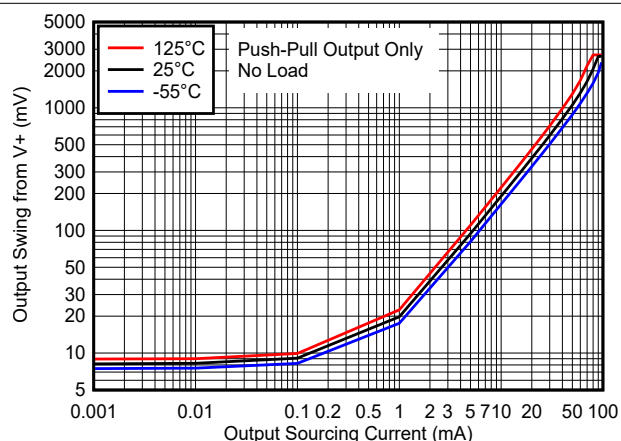


图 6-4. 输出摆幅与输出拉电流之间的关系 - 3.3V

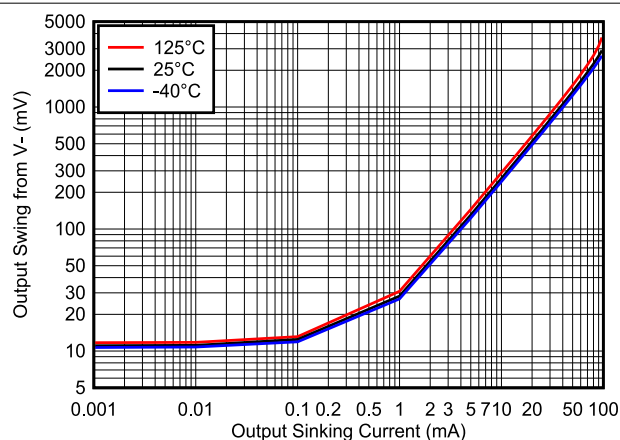


图 6-5. 输出摆幅与输出灌电流之间的关系 - 5V

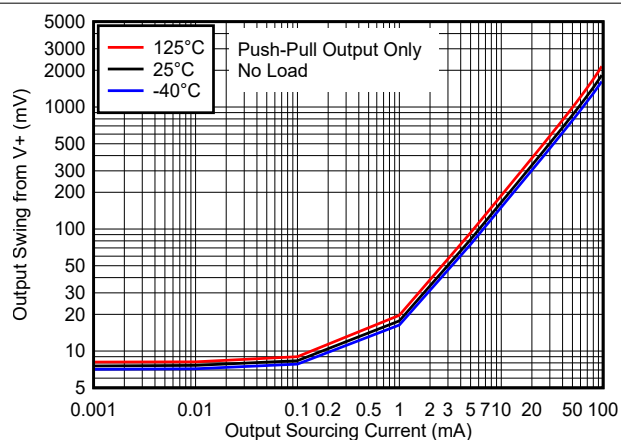


图 6-6. 输出摆幅与输出拉电流之间的关系 - 5V

6 典型特性 (续)

$T_A = 25^\circ\text{C}$, V_S (总电源电压) = $(V_+) - (V_-) = +5\text{V}$, $V_{CM} = V_S / 2$, $R_{PULLUP} = 1\text{M}\Omega$ 至 V_+ , $C_L = 15\text{pF}$, $V_{OD} = 100\text{mV}$, 除非另有说明。

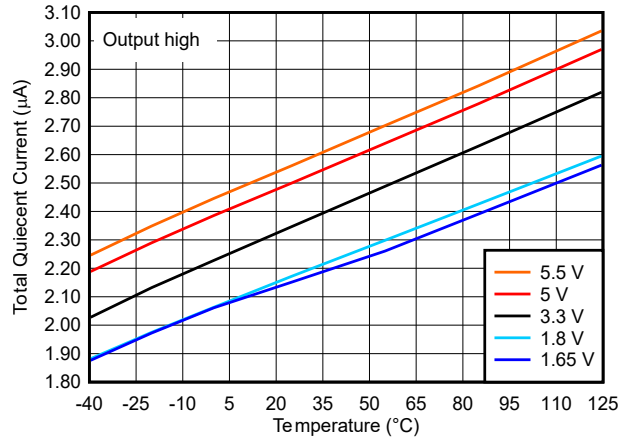


图 6-7. 电源电流与温度间的关系

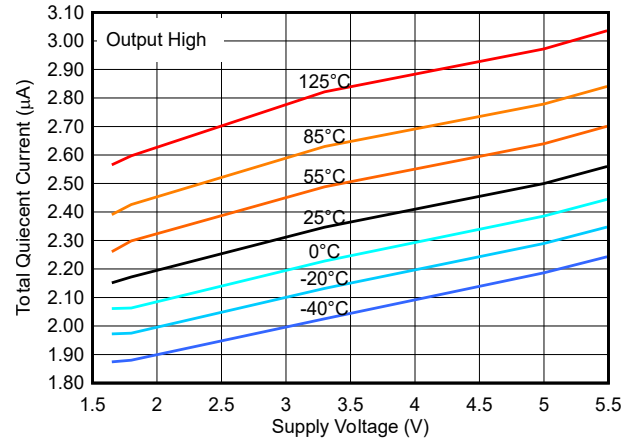


图 6-8. 电源电流与电源电压间的关系

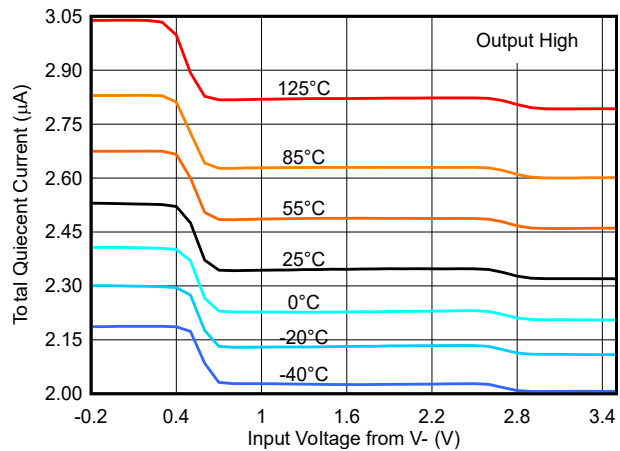


图 6-9. 电源电流与共模间的关系 - 3.3V

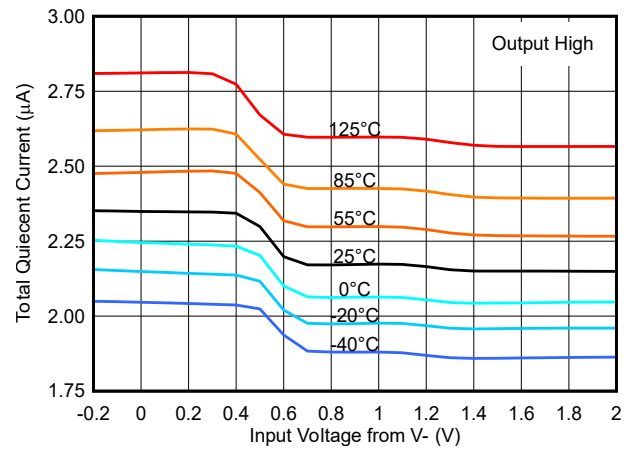


图 6-10. 电源电流与共模间的关系 - 1.8V

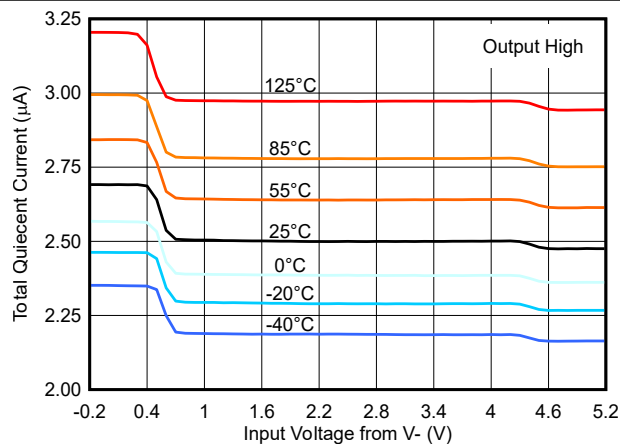


图 6-11. 电源电流与共模间的关系 - 5V

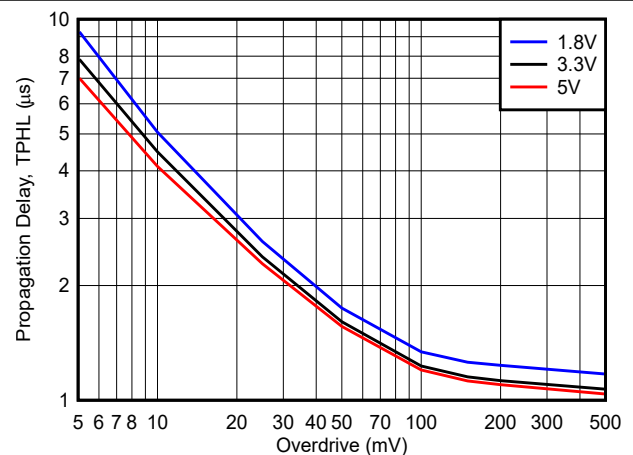


图 6-12. 从高电平到低电平传播延迟时间与过驱间的关系

6 典型特性 (续)

$T_A = 25^\circ\text{C}$, V_S (总电源电压) = $(V+) - (V-) = +5\text{V}$, $V_{CM} = V_S / 2$, $R_{PULLUP} = 1\text{M}\Omega$ 至 $V+$, $C_L = 15\text{pF}$, $V_{OD} = 100\text{mV}$, 除非另有说明。

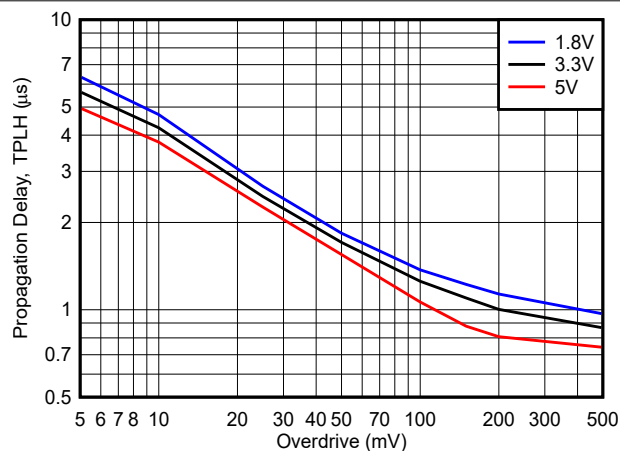


图 6-13. 从低电平到高电平传播延迟时间与过驱动间的关系

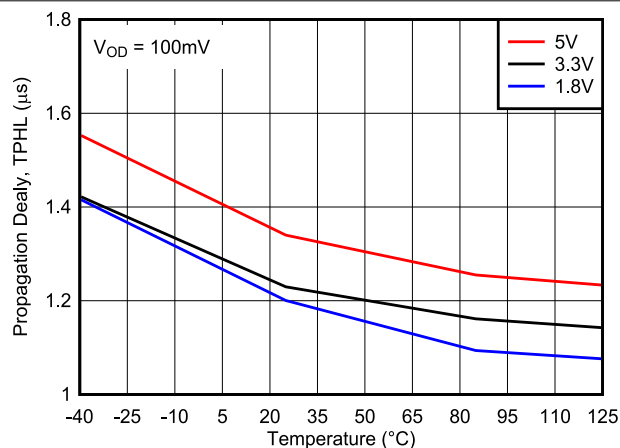


图 6-14. 从高电平到低电平传播延迟时间与温度间的关系

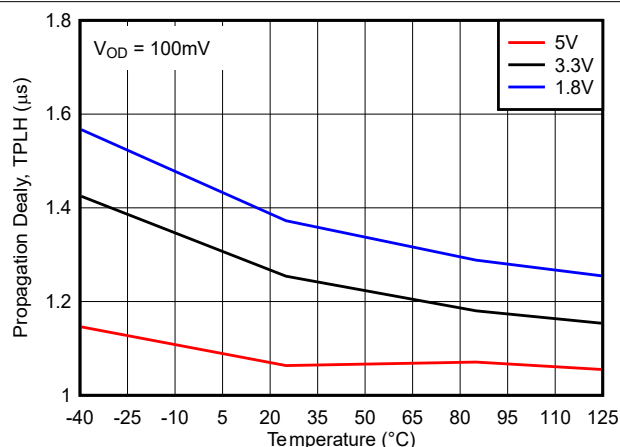


图 6-15. 从低电平到高电平传播延迟时间与温度间的关系

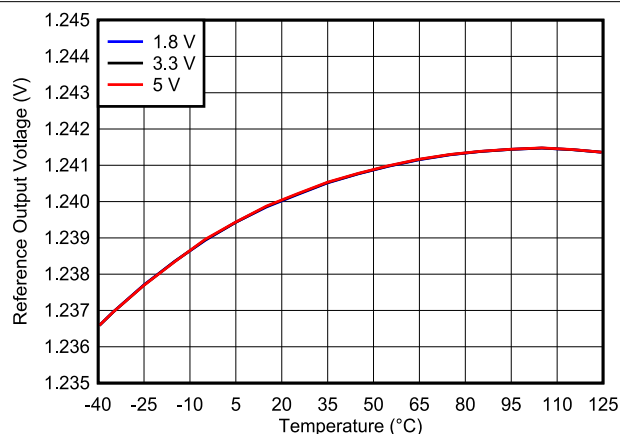


图 6-16. 基准电压与温度间的关系

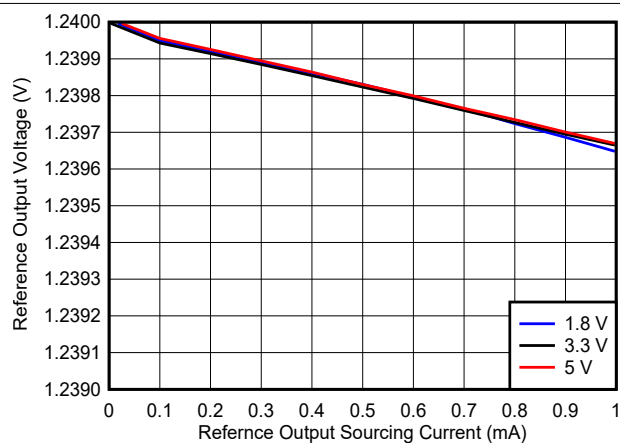


图 6-17. 基准电压与基准输出拉电流间的关系

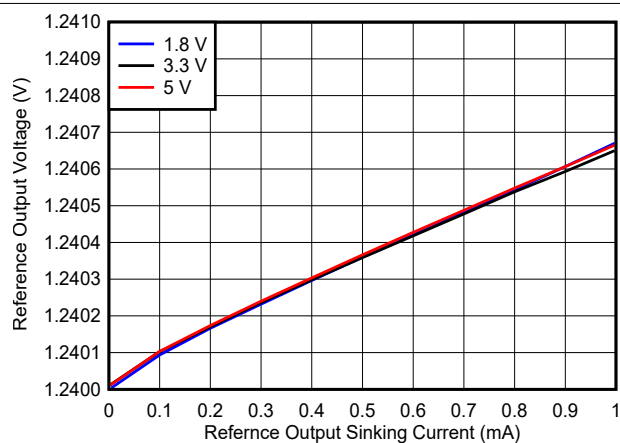


图 6-18. 基准电压与基准输出灌电流间的关系

6 典型特性 (续)

$T_A = 25^\circ\text{C}$, V_S (总电源电压) = $(V+) - (V-) = +5\text{V}$, $V_{CM} = V_S / 2$, $R_{PULLUP} = 1\text{M}\Omega$ 至 $V+$, $C_L = 15\text{pF}$, $V_{OD} = 100\text{mV}$, 除非另有说明。

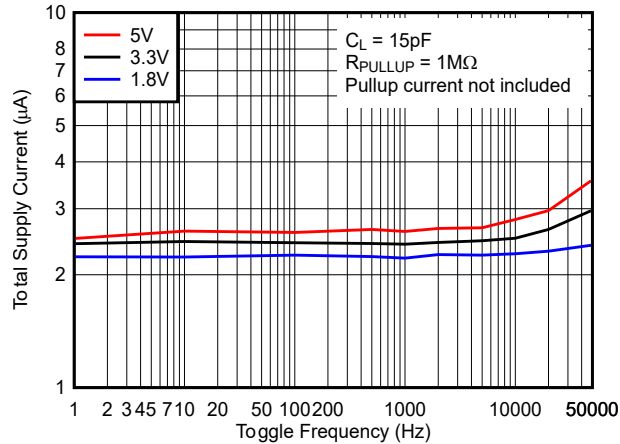


图 6-19. 电源电流与切换频率间的关系 - 开漏输出

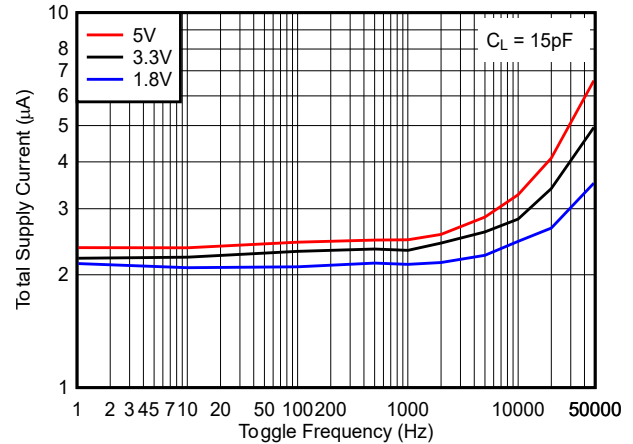


图 6-20. 电源电流与切换频率间的关系 - 推挽输出

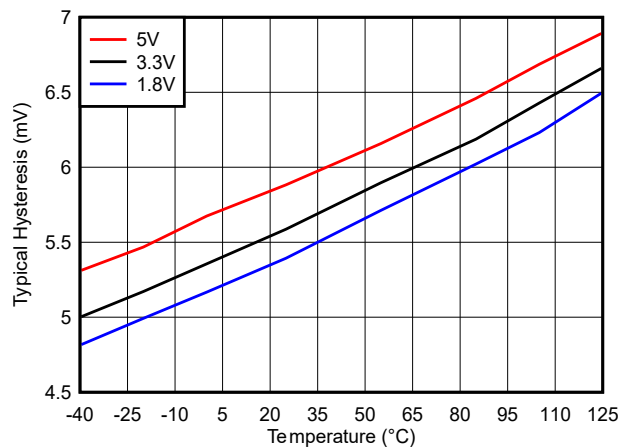


图 6-21. 迟滞电压与温度之间的关系

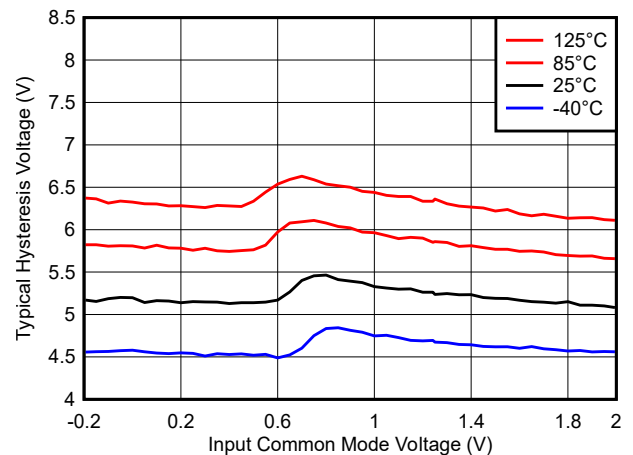


图 6-22. 迟滞电压与共模间的关系, 1.8V

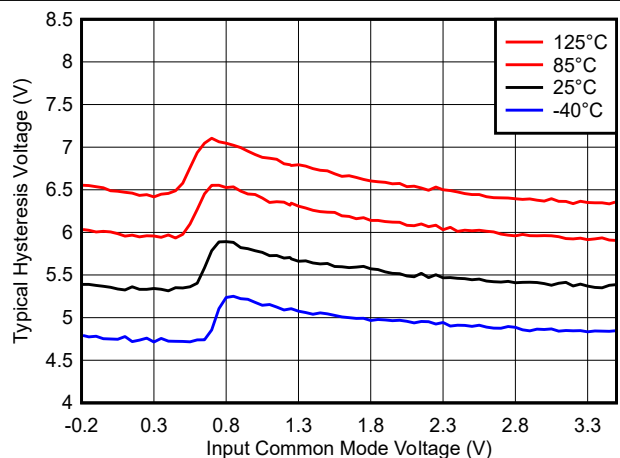


图 6-23. 迟滞电压与共模间的关系, 3.3V

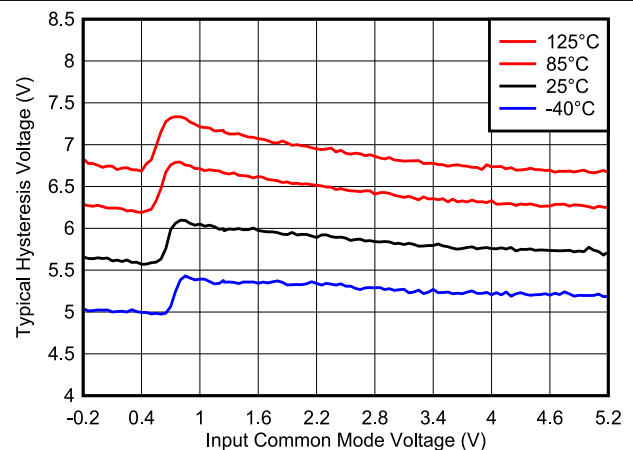


图 6-24. 迟滞电压与共模间的关系, 5V

6 典型特性 (续)

$T_A = 25^\circ\text{C}$, V_S (总电源电压) = $(V_+) - (V_-) = +5\text{V}$, $V_{CM} = V_S / 2$, $R_{PULLUP} = 1\text{M}\Omega$ 至 V_+ , $C_L = 15\text{pF}$, $V_{OD} = 100\text{mV}$, 除非另有说明。

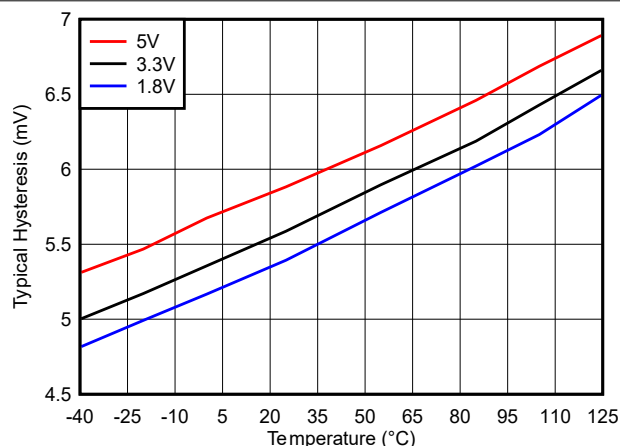


图 6-25. 迟滞电压与电源电压间的关系

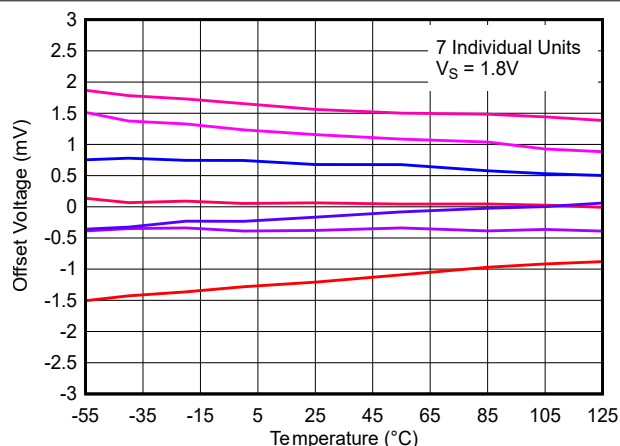


图 6-26. 失调电压与温度间的关系, 1.8V

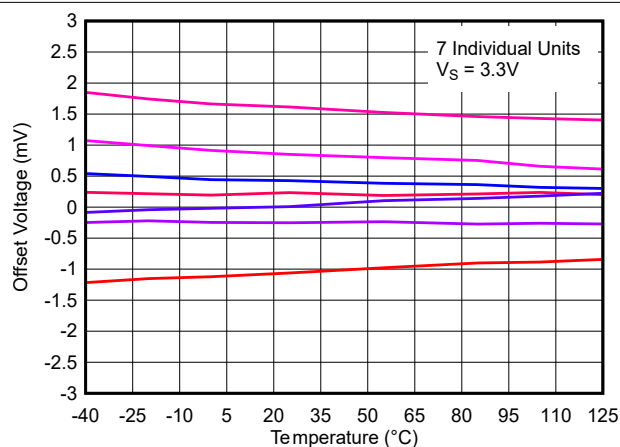


图 6-27. 失调电压与温度间的关系, 3.3V

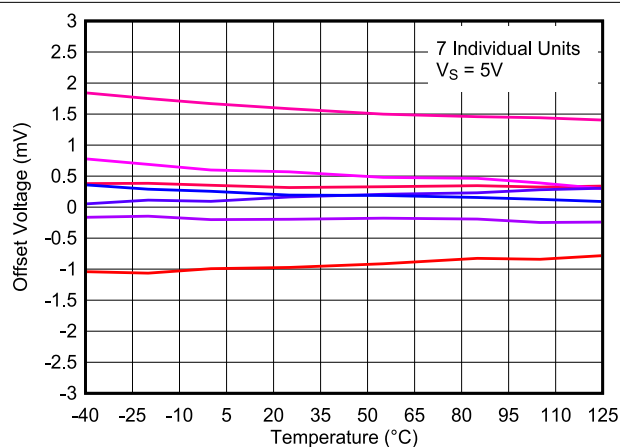


图 6-28. 失调电压与温度间的关系, 5V

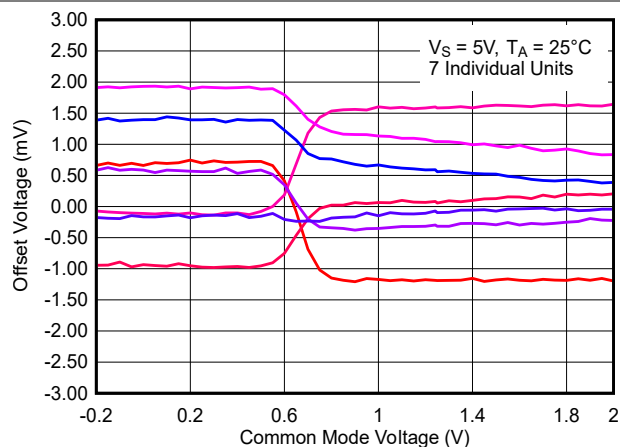


图 6-29. 失调电压与共模电压间的关系, 1.8V

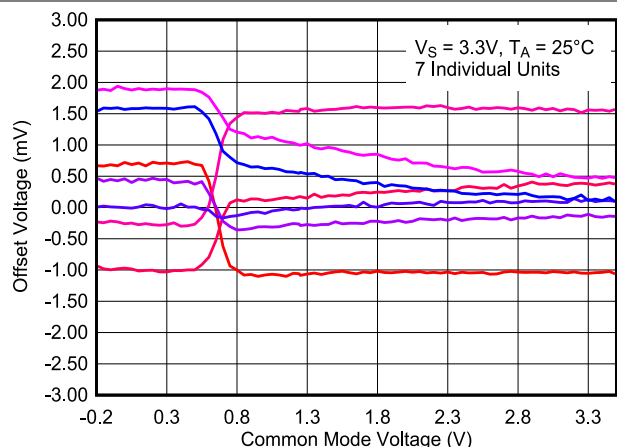


图 6-30. 失调电压与共模电压间的关系, 3.3V

6 典型特性 (续)

$T_A = 25^\circ\text{C}$, V_S (总电源电压) = $(V+) - (V-) = +5\text{V}$, $V_{CM} = V_S / 2$, $R_{PULLUP} = 1\text{M}\Omega$ 至 $V+$, $C_L = 15\text{pF}$, $V_{OD} = 100\text{mV}$, 除非另有说明。

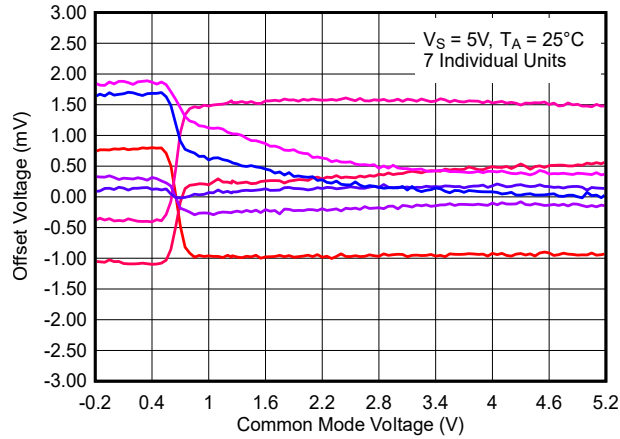


图 6-31. 失调电压与共模电压间的关系, 5V

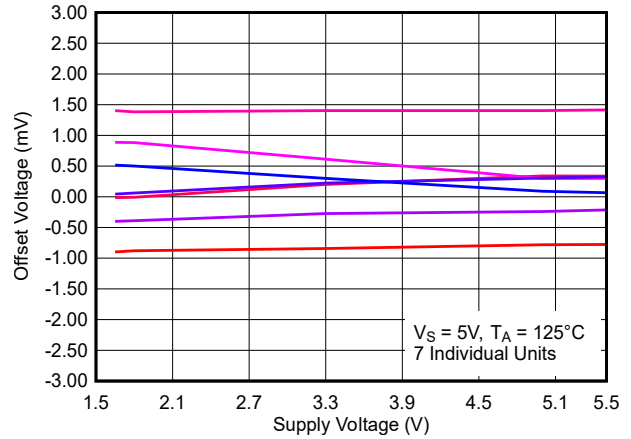


图 6-32. 失调电压与电源电压间的关系, 125°C

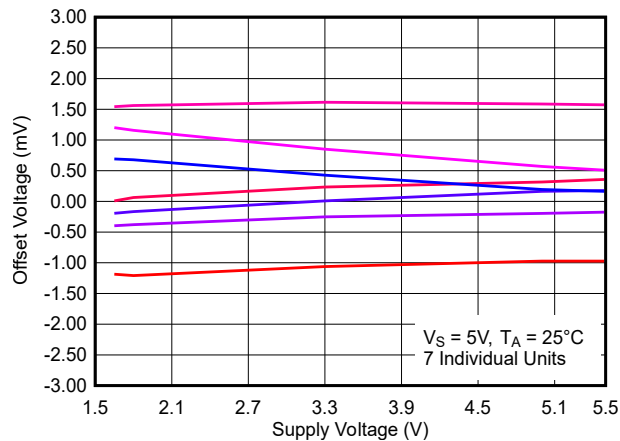


图 6-33. 失调电压与电源电压间的关系, 25°C

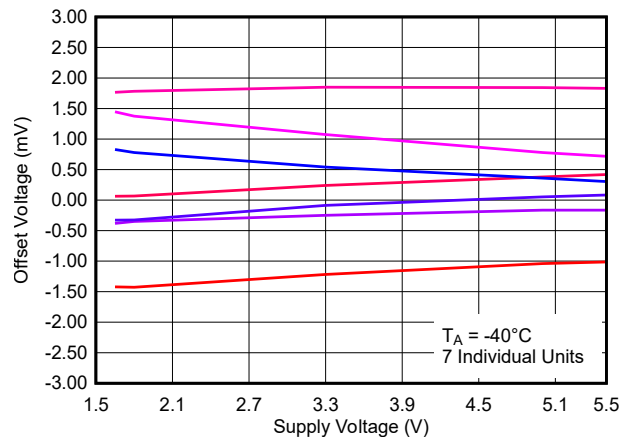


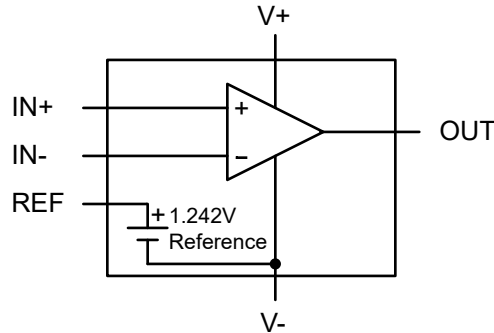
图 6-34. 失调电压与电源电压间的关系, -40°C

7 详细说明

7.1 概述

TLV301x-Q1 是一款具有集成基准的微功耗比较器，非常适合紧凑型低电流精密电压检测应用。TLV301x-Q1 具有 1.242V 的高精度内部基准电压和低静态电流，使功耗敏感型系统能够监测故障情况并快速做出响应。在整个数据表中，版本“B”仅在存在差异时指定。

7.2 功能方框图



7.3 特性说明

TLV301x-Q1 包含一个具有开漏或推挽输出选项的轨到轨输入比较器和一个外部可用的电压基准。

7.4 器件功能模式

TLV301x-Q1 要求比较器输出的工作电压介于 1.8V 至 5.5V 之间，以反映施加到输入端的电压。同样，基准输出 (REF) 在相同的工作电压范围内也有效。“B”版本增加了上电复位、失效防护输入和 1.65V 最小电源电压。

7.4.1 开漏输出 (TLV3011-Q1 和 TLV3011B-Q1)

TLV3011-Q1 具有开漏 (仅灌电流) 输出，允许通过单个上拉电阻器驱动多个器件以实现或功能，因此 TLV3011-Q1 适用于逻辑应用。当输出处于低电平状态时，由于汲取额外的电流，上拉电阻器的值和使用的电源电压会影响电流消耗。这种影响可以在“静态电流与输出开关频率间的关系”典型曲线中看到。

对于 TLV3011-Q1，上拉电压必须小于或等于 $V+$ 电源电压 ($V_{PULLUP} \leq V+$)。

无论电源电压如何，TLV3011B-Q1 输出均可上拉至任何高达 5.5V 的电压。

7.4.2 推挽输出 (TLV3012-Q1 和 TLV3012B-Q1)

TLV3012-Q1 具有“推挽”输出，既能灌入电流，也能拉出电流。推挽输出级无需上拉电阻器，并且不具有击穿电流，因此是功率预算较低应用的理想之选。请勿将推挽输出端连接在一起。

7.4.3 电压基准

集成的 1.242V 电压基准在一个单独的输出引脚上提供 100ppm/°C (最大值) 的低温漂，此引脚允许使用外部分压器或者为其他外部电路提供基准电压。该基准与高达 10nF 的容性负载搭配使用时可保持稳定，并且可灌入/拉出高达 500μA (典型值) 的输出电流。

7.4.4 内部迟滞

TLV301x-Q1 和 TLV301xB-Q1 的内置迟滞典型值为 6mV。仍然可以添加外部迟滞，如上一节 [添加外部迟滞](#) 所述。

7.4.5 TLV3011B-Q1 和 TLV3012B-Q1 失效防护输入

TLV3011B-Q1 和 TLV3012B-Q1 输入可实现高达 5.5V 的失效防护，与 V+ 电压无关。失效防护定义为当 V+ 未上电或在建议的工作范围内时保持相同的高输入阻抗。

失效防护输入可以是 0V 至 5.5V 之间的任意值，即使在 V+ 为零或上升/下降时也是如此。只要输入电压范围和电源电压在指定范围内，该特性就能够避免电源时序问题。之所以如此，是因为输入未钳位到 V+，即使在输入端施加更高电压，输入电流也会保持电流值。

只要其中一个输入引脚保持在有效输入范围内，并且电源电压有效，不处于 POR 状态，输出状态就是正确的。

以下是 TLV3011B-Q1 和 TLV3012B-Q1 器件输入电压偏移及结果的汇总：

1. 当 IN- 和 IN+ 都在指定的输入电压范围内时：
 - a. 如果 IN- 高于 IN+ 和失调电压，则输出为低电平。
 - b. 如果 IN- 低于 IN+ 和失调电压，则输出为高电平。
2. 当 IN- 高于指定的输入电压范围，而 IN+ 在指定的电压范围内时，输出为低电平。
3. 当 IN+ 高于指定的输入电压范围，而 IN- 在指定的输入电压范围内时，输出为高电平
4. 当 IN- 和 IN+ 均不在指定的输入电压范围内时，输出状态为**不确定**（随机）。*请勿*在此区域中运行。

由于输入没有到达 V+ 的上部 ESD 二极管钳位，如果电源可能超过 5.5V，则必须从外部将输入电压钳位到低于 5.5V。在输入瞬变的情况下，也建议将限流电阻器与输入串联。

7.4.6 TLV3011B-Q1 和 TLV3012B-Q1 上电复位

TLV3011B-Q1 和 TLV3012B-Q1 具有用于启动或断电条件已知的内部上电复位 (POR) 电路。当电源 (V+) 上升或下降时，POR 电路会在超过最小电源电压阈值后激活长达 1.9ms，在电源电压降至最小电源电压以下时立即激活。当电源电压大于等于最小电源电压时，经过延迟周期后，比较器输出将反映差分输入的状态 (V_{ID})。该延迟足够长，可使基准输出在高达 10nF 的容性负载下保持稳定。

在 POR 期间 (T_{ON})，输出如下：

- 开漏输出 TLV3011B-Q1 为高电平 (Hi-Z)。
- 推挽输出 TLV3012B-Q1 为低电平 (灌电流)。

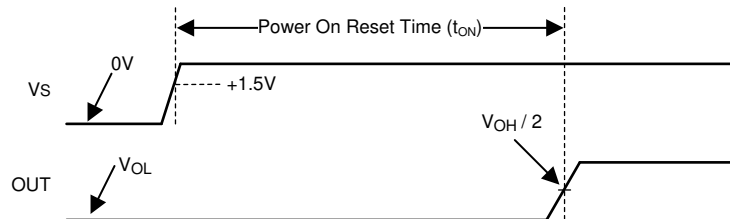


图 7-1. 推挽输出的上电复位示例时序图

请注意，集电极开路输出的性质是，在 HI-Z POR 期间，输出会随着上拉电压而上升。

8 应用和实施

备注

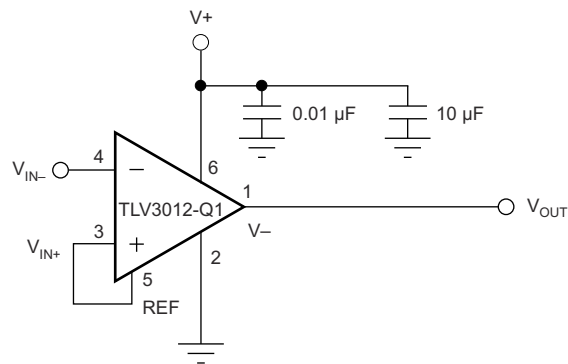
以下应用部分中的信息不属于 TI 器件规格的范围，TI 不担保其准确性和完整性。TI 的客户应负责确定器件是否适用于其应用。客户应验证并测试其设计，以确保系统功能。

8.1 应用信息

TLV301x-Q1 和 TLV301xB-Q1 比较器系列具有片上 1.242V 系列基准，可选择开漏或推挽输出级。

2.4 μA 的典型电源电流和小型封装与 1.65V 的电源要求相结合，使 TLV301xB-Q1 器件成为电池和便携式设计的理想选择。

下面显示了 TLV3012-Q1 器件的典型连接。



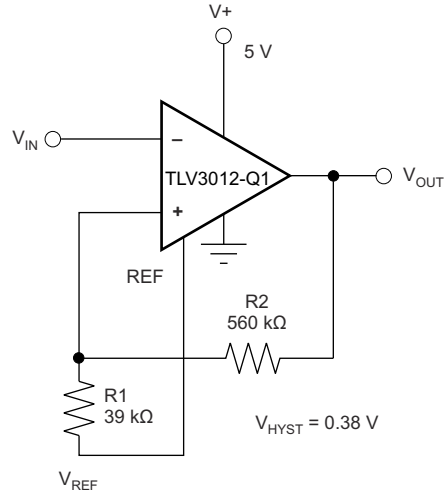
Copyright © 2016, Texas Instruments Incorporated

图 8-1. 基本连接

8.1.1 添加外部迟滞

对于有噪声的输入信号，当输入信号通过开关阈值时，比较器输出会显示多个开关。TLV301x-Q1 系列的典型迟滞为 6mV ($\pm 3\text{mV}$)。为了提高总体迟滞，可以通过将少量反馈连接到正输入来添加外部迟滞。该外部迟滞会增加内部迟滞。下面显示了用于引入外部迟滞的典型拓扑。

$$V_{\text{HYST}} = \frac{V_{+} \times R1}{R1 + R2} \quad (1)$$



Copyright © 2016, Texas Instruments Incorporated

图 8-2. 添加外部迟滞

V_{HYST} 电压通过提高阈值区域来设置切换比较器输出所需的转换电压值，从而降低对噪声的敏感度。

8.2 典型应用

8.2.1 欠压检测

通常需要进行欠压检测，以提醒系统电池电压已降至可用电压电平以下。图 23 显示了一个使用 TLV3012-Q1 的简单欠压检测电路，该电路配置为具有集成 1.242V 基准电压的同相比较器，从外部连接到反相输入引脚 (IN-)。

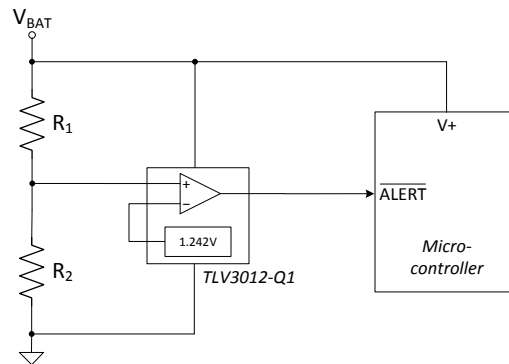


图 8-3. 欠压检测

8.2.1.1 设计要求

对于此设计，请遵循以下设计要求：

- 由为微控制器供电的电源供电。
- 欠压警报低电平有效。
- 当 V_{BAT} 小于 2.0V 时输出逻辑低电平。

8.2.1.2 详细设计过程

配置电路，如上方所示。将 (V+) 连接至 V_{BAT} ，此电压也为微控制器供电。电阻 R_1 和 R_2 会产生 2.0V 的欠压警报级别。当电池电压降至 2.0V 时，电阻分压器电压超过 V_{REF} ，即 TLV3012-Q1 的 1.242V 基准阈值。这会导致比较器输出从逻辑高电平转换为逻辑低电平。选择 TLV3012-Q1 的推挽输出是因为比较器工作电压与接收欠压警报信号的微控制器共享。

方程式 2 是根据对图 8-3 的分析得到的。

$$V_{REF} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \times V_{BAT} \quad (2)$$

其中

- R_1 和 R_2 是连接到 IN+ 的电阻分压器的电阻值
- V_{BAT} 是被监视是否存在欠压情况的电压源。
- V_{REF} 是下降沿阈值，在达到此阈值时，比较器输出状态从高电平变为低电平

变换该方程并求解 R_1 即可得到该结果。

$$R_1 = \frac{(V_{BAT} - V_{REF})}{V_{REF}} \times R_2 \quad (3)$$

对于使用 TLV3012-Q1 进行 2.0V 的特定欠压检测，将计算以下结果。

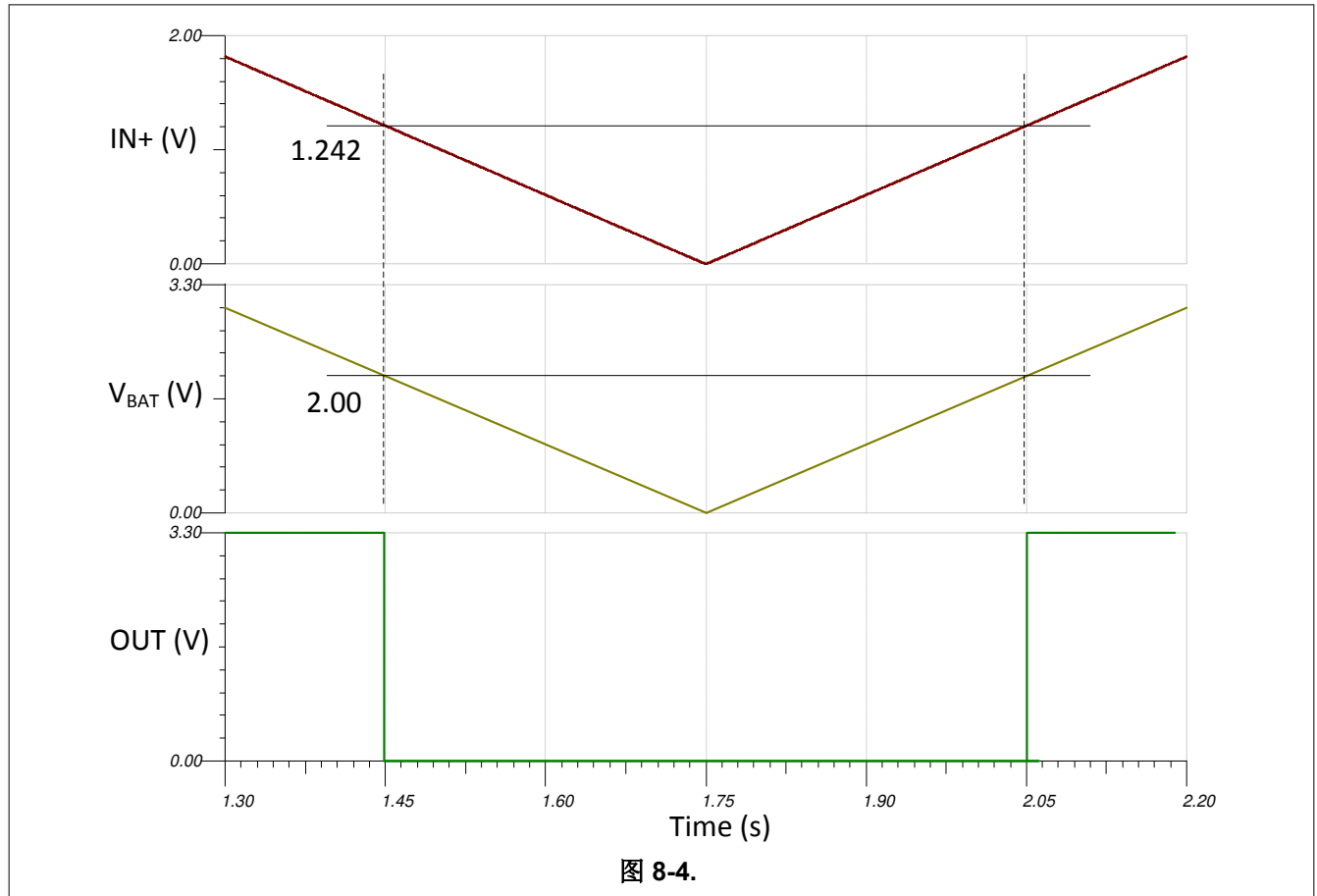
$$R_1 = \frac{(2.0 - 1.242)}{1.242} \times 1M = 610 \text{ k}\Omega \quad (4)$$

其中

- R_2 设置为 $1M\Omega$
- V_{BAT} 设置为 2.0V
- V_{REF} 设置为 1.242V

选择 R_{TOTAL} ($R_1 + R_2$)，使流经分压器的电流至少比输入偏置电流 (I_{BIAS}) 高 100 倍。电阻器可以具有高值，以更大幅度地减小电路中的电流消耗，而不会使电阻分压器的误差显著增加。

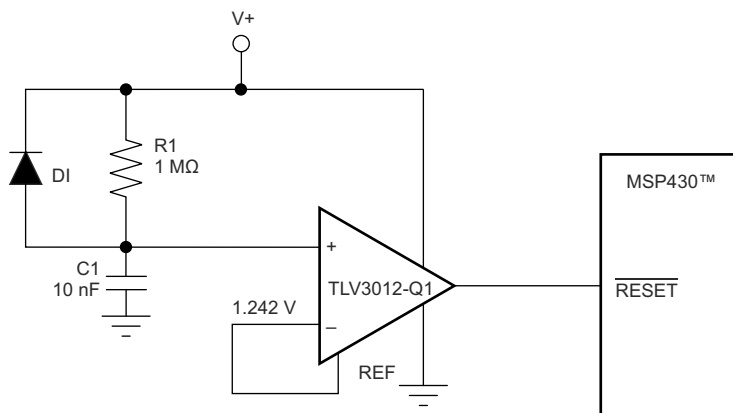
8.2.1.3 应用曲线



8.3 系统示例

8.3.1 上电复位

下方所示的复位电路为 **MSP430™** 微控制器提供了延时复位释放。电路的运行基于电源电压的稳定时间常数，而不是基于预先确定的电压值。负输入是由内部电压基准生成的基准电压。正输入是提供上电延迟的 **RC** 电路。加电时，比较器的输出为低电平，使处理器保持在复位状态。只有在电源电压稳定后，比较器的正输入才会高于负输入，从而产生高输出状态，释放处理器以便进行操作。电源电压所需的稳定时间可通过选择 **RC** 元件值来调节。在电路的这一部分使用较低值的电阻器不会增加流耗，这是因为电源稳定后，没有电流流经 **RC** 电路。



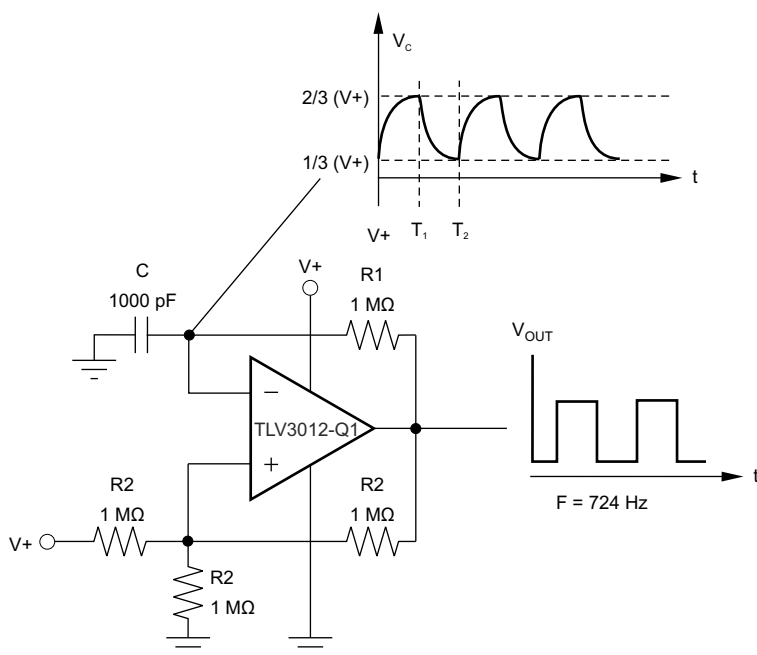
Copyright © 2016, Texas Instruments Incorporated

图 8-5. TLV3012-Q1 配置为 MSP430™ 微控制器的上电复位电路

所需的复位延迟取决于系统电源的上电特性。选择 R_1 和 C_1 可使电源有足够的时间稳定。 D_1 在断电时提供快速复位。在此示例中， $R_1 \times C_1$ 时间常数为 10ms。

8.3.2 张弛振荡器

如下方所示，TLV3012-Q1 器件可配置为张弛振荡器，以提供简单且经济的时钟输出。电容器的充电速率为 $T = 0.69RC$ ，放电速率为 $0.69RC$ 。因此，周期为 $T = 1.38RC$ 。 R_1 的值与 R_2 不同。



Copyright © 2016, Texas Instruments Incorporated

图 8-6. TLV3012-Q1 配置为张弛振荡器

8.4 电源相关建议

TLV3012-Q1 的建议工作电压范围 (V_S) 为 1.8V 至 5.5V。 V_S 的定义是 $(V+) - (V-)$ 。因此，用于产生 V_S 的电源电压可以是单端或双极的。例如，5V 和 0V 的单端电源电压以及 +2.5V 和 -2.5V 的双极电源电压可为 V_S 创造相当的工作电压。然而，当使用双极电源电压时，需要意识到比较器输出的基准 (REF) 和逻辑低电平以 (V-) 为基准。输出容性负载和输出触发速率会导致平均电源电流上升到超过 EC 表中的静态电流。

8.5 布局

8.5.1 布局指南

为了尽可能降低电源噪声，电源应通过 0.1 μ F 陶瓷电容器进行电容去耦。比较器对输入噪声很敏感，正确接地（使用接地层）、电源旁路和高阻抗节点保护等预防措施可更大限度地降低噪声的影响并有助于达到指定的性能。

8.5.2 布局示例

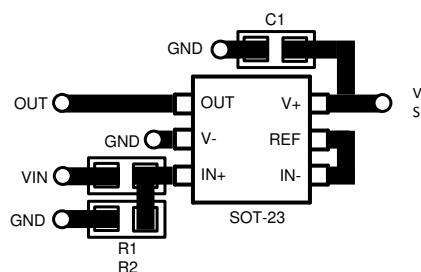


图 8-7. 布局示例

9 器件和文档支持

9.1 接收文档更新通知

要接收文档更新通知，请导航至 ti.com 上的器件产品文件夹。点击 [通知](#) 进行注册，即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息，请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。

9.2 支持资源

TI E2E™ 中文支持论坛 是工程师的重要参考资料，可直接从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索现有解答或提出自己的问题，获得所需的快速设计帮助。

链接的内容由各个贡献者“按原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范，并且不一定反映 TI 的观点；请参阅 TI 的 [使用条款](#)。

9.3 商标

MSP430™ is a trademark of Texas Instruments.

TI E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

所有商标均为其各自所有者的财产。

9.4 静电放电警告



静电放电 (ESD) 会损坏这个集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理和安装程序，可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级，大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏，这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

9.5 术语表

TI 术语表

本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。

10 修订历史记录

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

Changes from Revision C (April 2023) to Revision D (January 2025)	Page
• 删除了 仅限 TLV3012-Q1 DCK 封装绝对最大值 表 (合并为一个表)	1
• 删除了 仅限 TLV3012-Q1 DCK 封装热性能信息 表 (合并为一个表)	1
• 删除了 仅限 TLV3012-Q1 DCK 封装电气特性 表 (合并为一个表)	1
• 删除了 仅限 TLV3012-Q1 DCK 封装开关特性 表 (合并为一个表)	1
• 删除了 仅限 TLV3012-Q1 DCK 封装典型特性 曲线	1
• 将首页的 器件信息 表标题更改为 封装信息	1
• 更新了电源电流图	8

Changes from Revision B (August 2022) to Revision C (April 2023)	Page
• 向首页文本和表中添加了 TLV3011B-Q1 和 TLV3012B-Q1	1

Changes from Revision A (June 2019) to Revision B (August 2022)	Page
• 在 DBV 和 DCK 封装中添加了 TLV3011-Q1	1
• 在 SOT-23 (DBV) 中添加了 TLV3012-Q1	1
• 为 DBV 封装添加了新表	1
• 更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式	1

Changes from Revision * (March 2011) to Revision A (June 2019)

Page

• 添加了 HBM 和 CDM ESD 等级和分级等级还添加了 AEC-Q100 器件温度等级.....	1
• 添加了引脚配置和功能部分、ESD 等级表、特性说明部分、器件功能模式、应用和实施部分、电源相关建议部分、布局部分、器件和文档支持部分以及机械、封装和可订购信息部分.....	1
• 从数据表中删除了 TLV3011-Q1 器件，并从 TLV3012-Q1 器件型号中删除了 A	1
• 删除了封装订购信息部分.....	3

11 机械、封装和可订购信息

下述页面包含机械、封装和订购信息。这些信息是指定器件可用的最新数据。数据如有变更，恕不另行通知，且不会对此文档进行修订。有关此数据表的浏览器版本，请查阅左侧的导航栏。

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
TLV3011AQDBVRQ1	Active	Production	SOT-23 (DBV) 6	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	2Q7F
TLV3011AQDBVRQ1.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) 6	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	2Q7F
TLV3011AQDCKRQ1	Active	Production	SC70 (DCK) 6	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	1M6
TLV3011AQDCKRQ1.A	Active	Production	SC70 (DCK) 6	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	1M6
TLV3011BQDBVRQ1	Active	Production	SOT-23 (DBV) 6	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	31IF
TLV3011BQDBVRQ1.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) 6	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	31IF
TLV3011BQDCKRQ1	Active	Production	SC70 (DCK) 6	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	1O6
TLV3011BQDCKRQ1.A	Active	Production	SC70 (DCK) 6	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	1O6
TLV3012AQDBVRQ1	Active	Production	SOT-23 (DBV) 6	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	2Q8F
TLV3012AQDBVRQ1.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) 6	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	2Q8F
TLV3012AQDCKRQ1	Active	Production	SC70 (DCK) 6	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	BPF
TLV3012AQDCKRQ1.A	Active	Production	SC70 (DCK) 6	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	BPF
TLV3012AQDCKRQ1.B	Active	Production	SC70 (DCK) 6	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	BPF
TLV3012BQDBVRQ1	Active	Production	SOT-23 (DBV) 6	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	31JF
TLV3012BQDBVRQ1.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) 6	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	31JF
TLV3012BQDCKRQ1	Active	Production	SC70 (DCK) 6	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	1O7
TLV3012BQDCKRQ1.A	Active	Production	SC70 (DCK) 6	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	1O7

⁽¹⁾ **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

⁽²⁾ **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

⁽³⁾ **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

⁽⁴⁾ **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

⁽⁵⁾ **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

(6) Part marking: There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

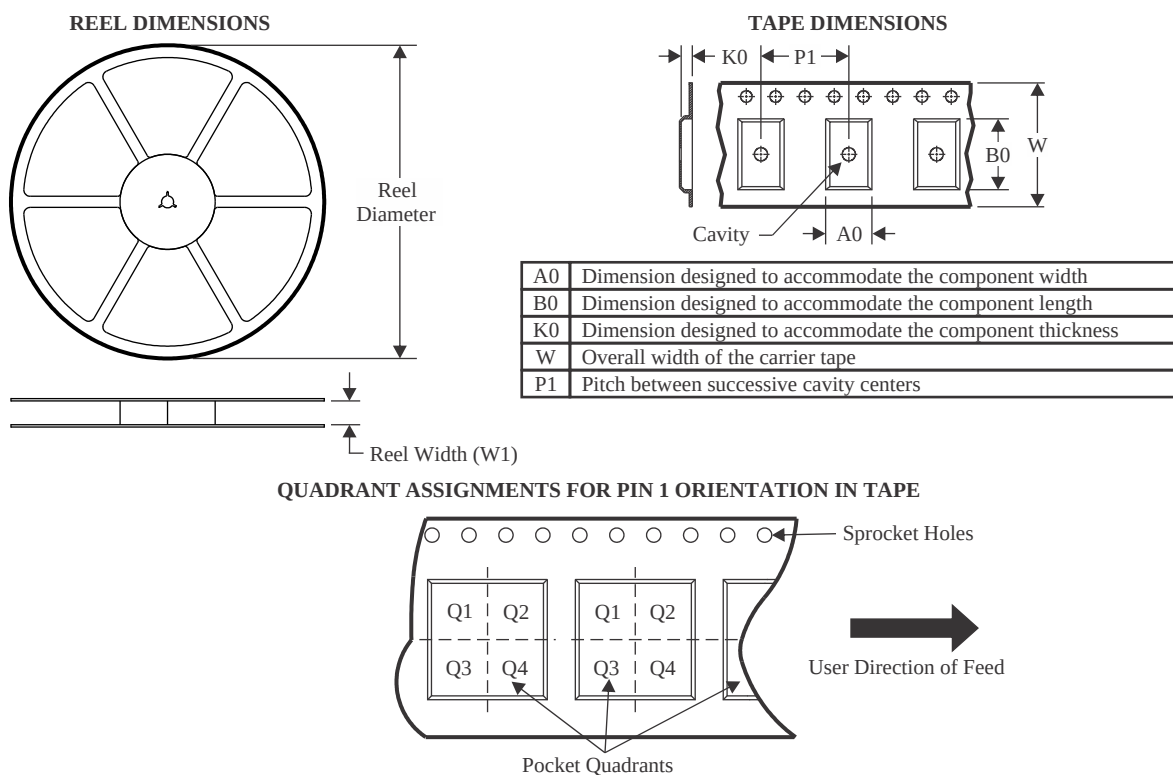
OTHER QUALIFIED VERSIONS OF TLV3011-Q1, TLV3011B-Q1, TLV3012-Q1, TLV3012B-Q1 :

- Catalog : [TLV3011](#), [TLV3011B](#), [TLV3012](#), [TLV3012B](#)
- Enhanced Product : [TLV3011-EP](#), [TLV3012-EP](#)

NOTE: Qualified Version Definitions:

- Catalog - TI's standard catalog product
- Enhanced Product - Supports Defense, Aerospace and Medical Applications

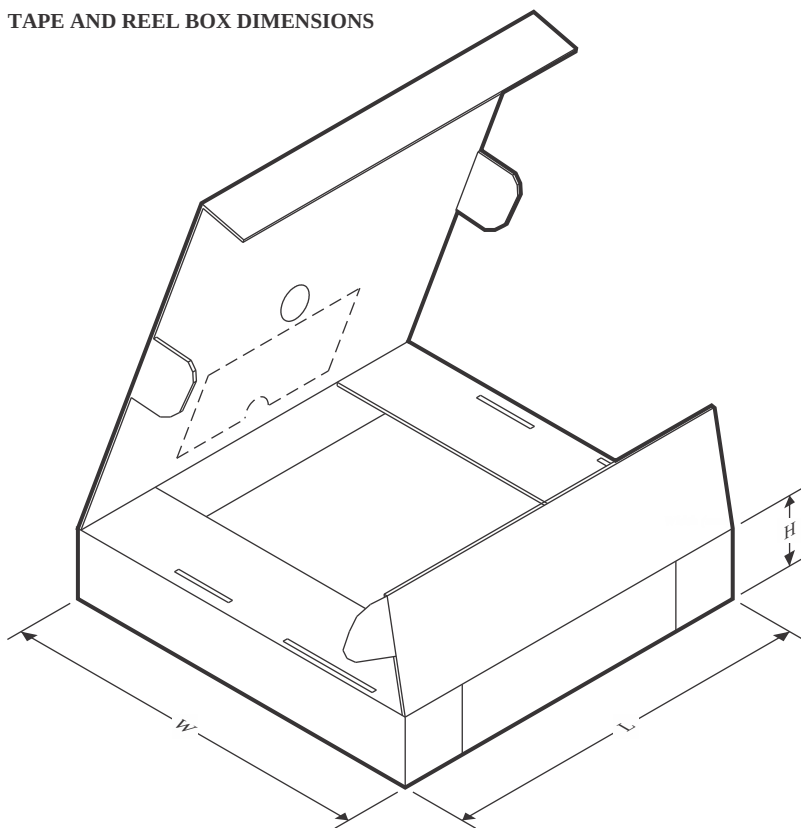
TAPE AND REEL INFORMATION



*All dimensions are nominal

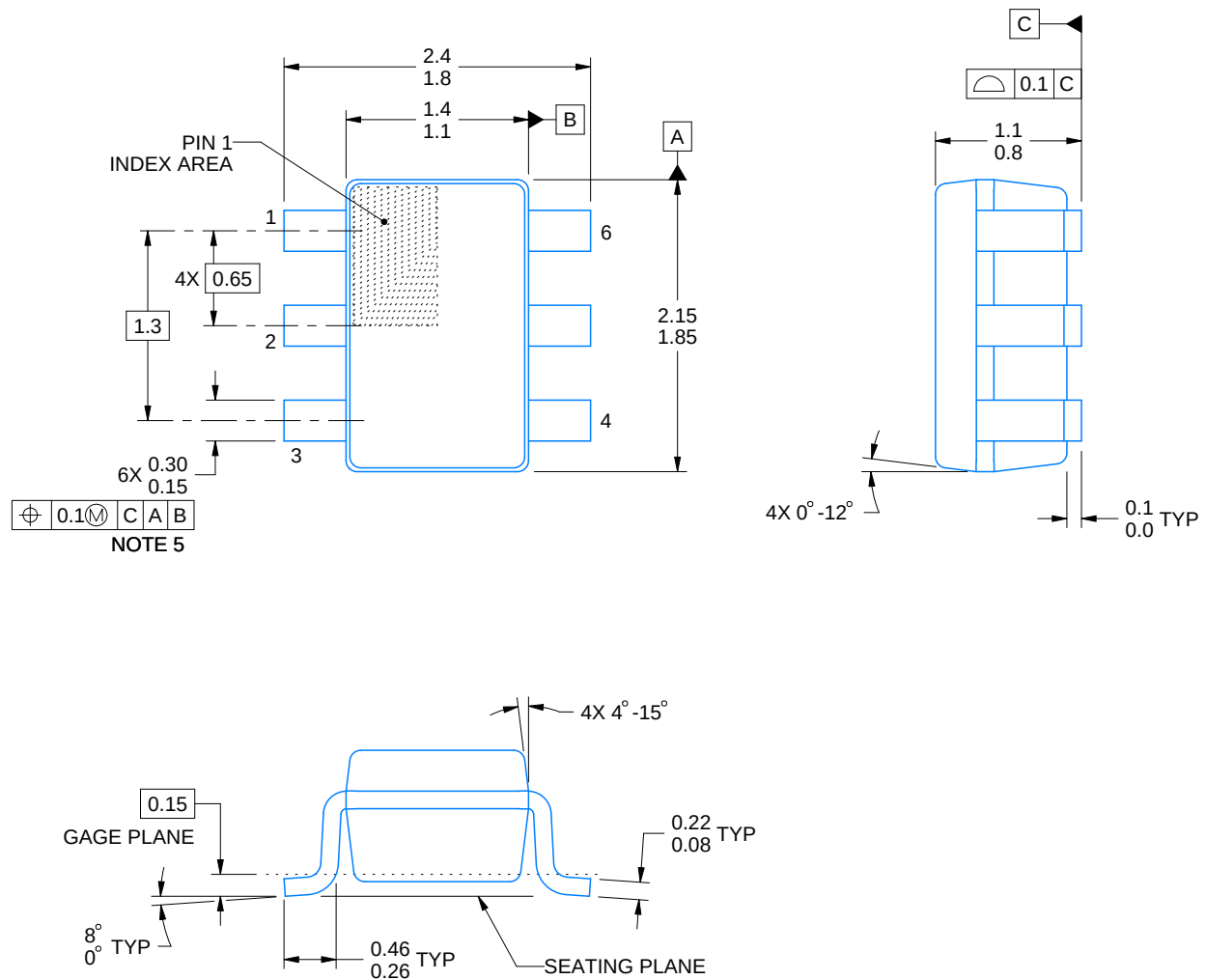
Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
TLV3011AQDBVRQ1	SOT-23	DBV	6	3000	180.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
TLV3011AQDCKRQ1	SC70	DCK	6	3000	178.0	9.0	2.4	2.5	1.2	4.0	8.0	Q3
TLV3011BQDBVRQ1	SOT-23	DBV	6	3000	180.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
TLV3011BQDCKRQ1	SC70	DCK	6	3000	178.0	9.0	2.4	2.5	1.2	4.0	8.0	Q3
TLV3012AQDBVRQ1	SOT-23	DBV	6	3000	180.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
TLV3012AQDCKRQ1	SC70	DCK	6	3000	178.0	9.0	2.4	2.5	1.2	4.0	8.0	Q3
TLV3012BQDBVRQ1	SOT-23	DBV	6	3000	180.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
TLV3012BQDCKRQ1	SC70	DCK	6	3000	178.0	9.0	2.4	2.5	1.2	4.0	8.0	Q3

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



*All dimensions are nominal

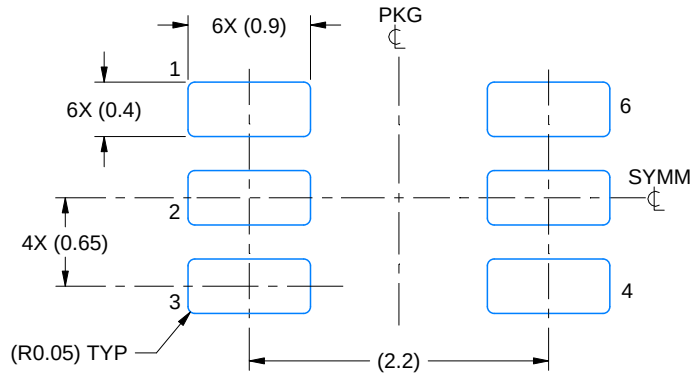
Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
TLV3011AQDBVRQ1	SOT-23	DBV	6	3000	210.0	185.0	35.0
TLV3011AQDCKRQ1	SC70	DCK	6	3000	180.0	180.0	18.0
TLV3011BQDBVRQ1	SOT-23	DBV	6	3000	210.0	185.0	35.0
TLV3011BQDCKRQ1	SC70	DCK	6	3000	180.0	180.0	18.0
TLV3012AQDBVRQ1	SOT-23	DBV	6	3000	210.0	185.0	35.0
TLV3012AQDCKRQ1	SC70	DCK	6	3000	180.0	180.0	18.0
TLV3012BQDBVRQ1	SOT-23	DBV	6	3000	210.0	185.0	35.0
TLV3012BQDCKRQ1	SC70	DCK	6	3000	180.0	180.0	18.0



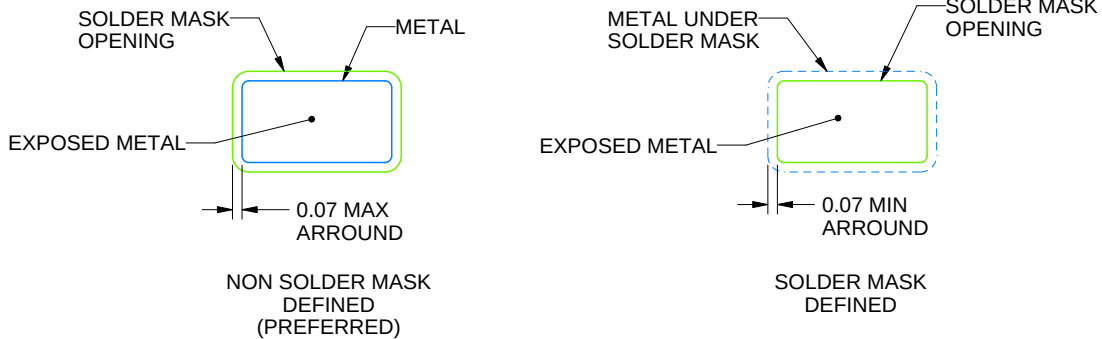
4214835/D 11/2024

NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. Body dimensions do not include mold flash or protrusion. Mold flash and protrusion shall not exceed 0.15 per side.
4. Falls within JEDEC MO-203 variation AB.



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE:18X

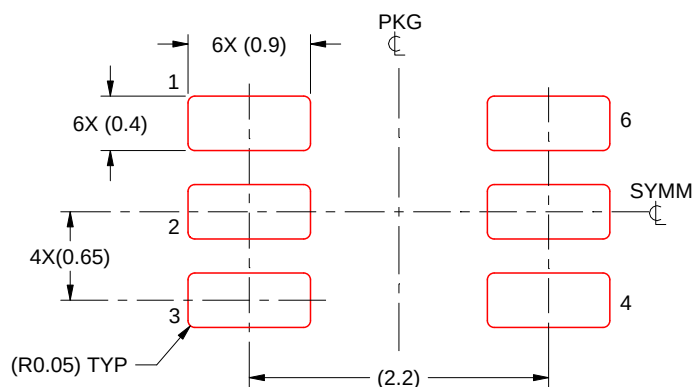


SOLDER MASK DETAILS

4214835/D 11/2024

NOTES: (continued)

5. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
6. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 THICK STENCIL
SCALE:18X

4214835/D 11/2024

NOTES: (continued)

7. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
8. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

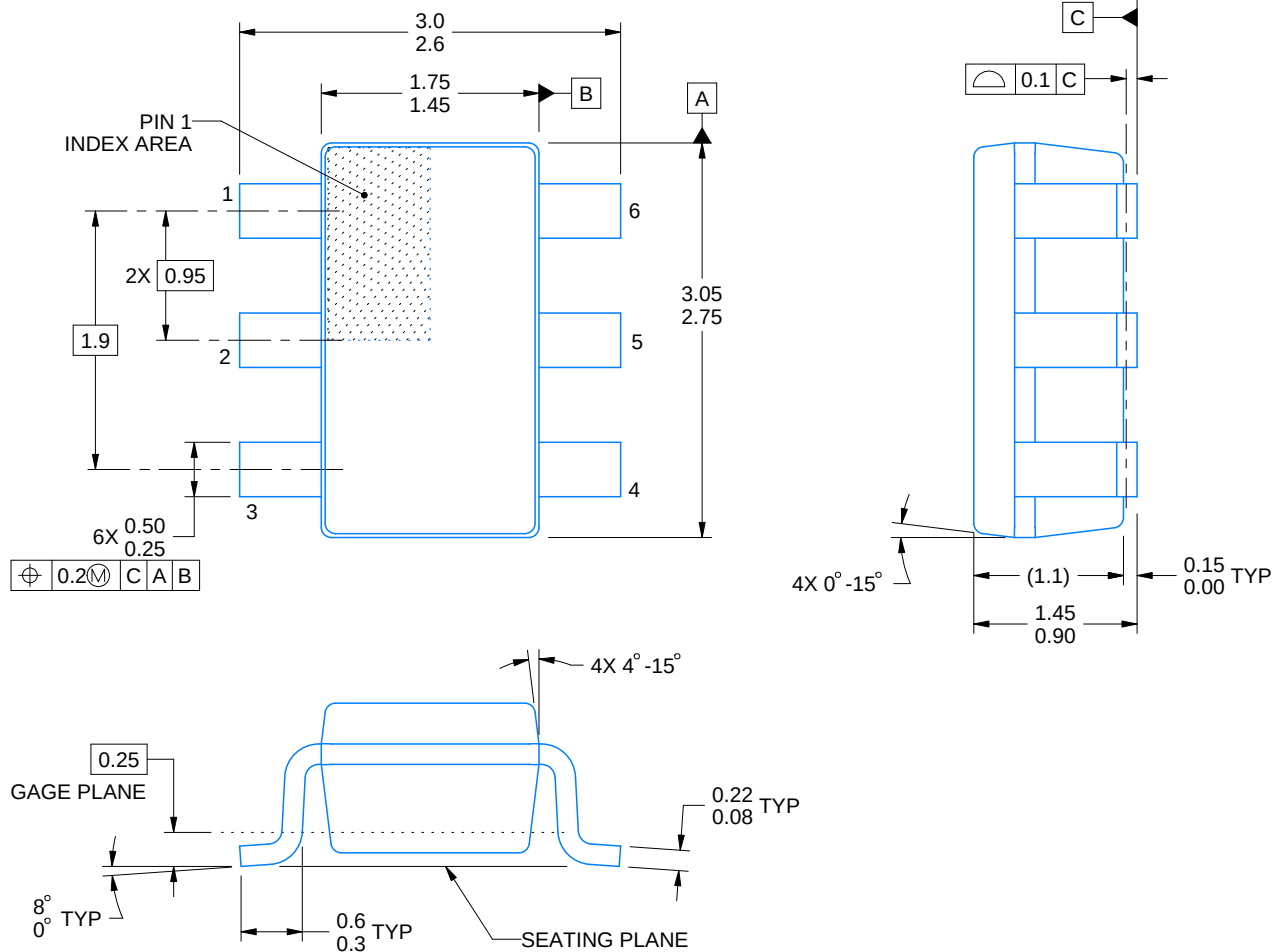
DBV0006A



PACKAGE OUTLINE

SOT-23 - 1.45 mm max height

SMALL OUTLINE TRANSISTOR



4214840/G 08/2024

NOTES:

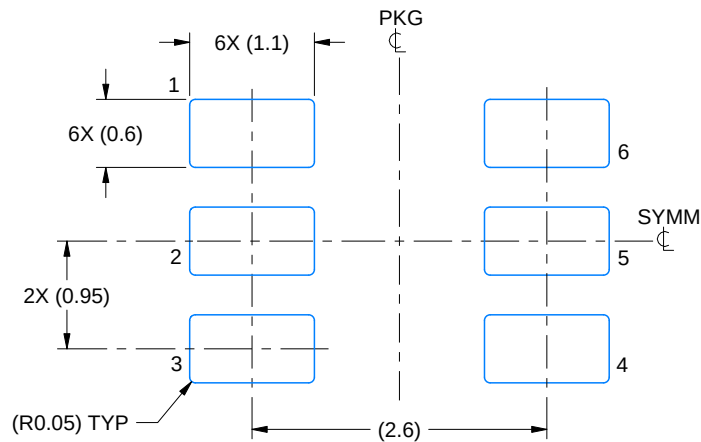
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. Body dimensions do not include mold flash or protrusion. Mold flash and protrusion shall not exceed 0.25 per side.
4. Leads 1,2,3 may be wider than leads 4,5,6 for package orientation.
5. Reference JEDEC MO-178.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

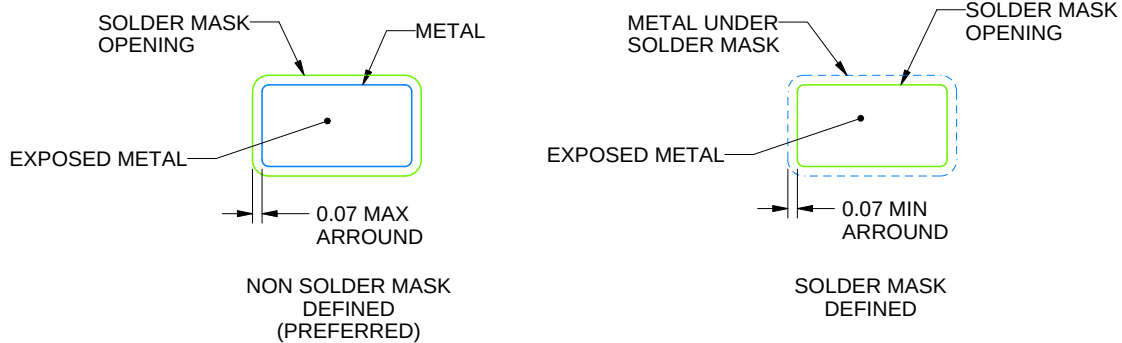
DBV0006A

SOT-23 - 1.45 mm max height

SMALL OUTLINE TRANSISTOR



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE:15X



SOLDER MASK DETAILS

4214840/G 08/2024

NOTES: (continued)

6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.

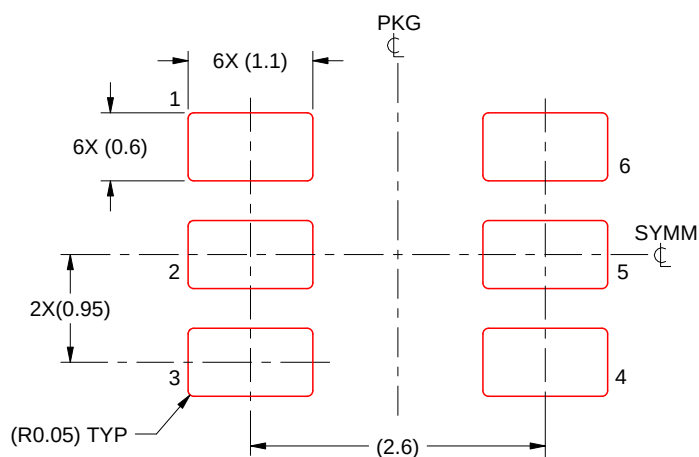
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

DBV0006A

SOT-23 - 1.45 mm max height

SMALL OUTLINE TRANSISTOR



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE:15X

4214840/G 08/2024

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

重要通知和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。严禁以其他方式对这些资源进行复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 的销售条款](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
版权所有 © 2025，德州仪器 (TI) 公司